

# 三菱半導体(トランジスタ) 2SB1035

低周波電力増幅用  
シリコンPNPエピタキシャル形

## 概要

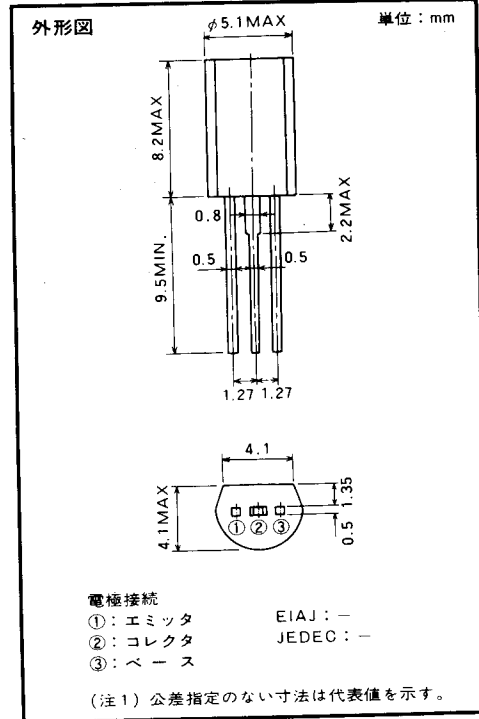
2SB1035は、樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャル形トランジスタで、特にコレクタ損失およびコレクタ電流が大きく設計、製造されており、2~3.5W出力の低周波電力増幅用として2SD1447とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

## 特長

- コレクタ損失が大きい  $P_{Cmax}=900mW$
- コレクタ電流が大きい  $I_{CM}=-1.5A$
- $h_{FE}$ の直線性がよい
- 利得帯域幅積が高い  $f_T=100MHz$ 標準

## 用途

ラジオ、テープレコーダ、小形ステレオ等の2~3.5W出力の低周波電力増幅回路



## 最大定格 (Ta=25°C)

記号	項目	定格値	単位
V <sub>CB0</sub>	コレクタ・ベース間電圧	-30	V
V <sub>EB0</sub>	エミッタ・ベース間電圧	-4	V
V <sub>CE0</sub>	コレクタ・エミッタ間電圧	-25	V
I <sub>CM</sub>	せん頭コレクタ電流	-1.5	A
I <sub>C</sub>	コレクタ電流	-1	A
P <sub>C</sub>	コレクタ損失 (Ta=25°C)	900	mW
T <sub>j</sub>	接合部温度	+150	°C
T <sub>stg</sub>	保存温度	-55~+150	°C

## 電気的特性 (Ta=25°C)

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
V <sub>(BR)CB0</sub>	コレクタ・ベース降伏電圧	I <sub>C</sub> =-10μA, I <sub>E</sub> =0	-30		-	V
V <sub>(BR)EB0</sub>	エミッタ・ベース降伏電圧	I <sub>E</sub> =-10μA, I <sub>C</sub> =0	-4			V
V <sub>(BR)CE0</sub>	コレクタ・エミッタ降伏電圧	I <sub>C</sub> =-100μA, R <sub>BE</sub> =∞	-25			V
I <sub>CB0</sub>	コレクタしゃ断電流	V <sub>CB</sub> =-25V, I <sub>E</sub> =0			-1	μA
I <sub>EB0</sub>	エミッタしゃ断電流	V <sub>EB</sub> =-2V, I <sub>C</sub> =0			-1	μA
h <sub>FE</sub> †	直流電流増幅率	V <sub>CE</sub> =-1V, I <sub>C</sub> =-500mA	55		300	-
V <sub>CE(sat)</sub>	コレクタ・エミッタ飽和電圧	I <sub>C</sub> =-500mA, I <sub>B</sub> =-25mA			-0.5	V
f <sub>T</sub>	利得帯域幅積	V <sub>CE</sub> =-6V, I <sub>E</sub> =10mA		100		MHz

†: h<sub>FE</sub>の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	C	D	E
h <sub>FE</sub>	55~110	90~180	150~300